



Transistor NPN Epitaxial / 30 MHz / 13.5 Vcc / 70 W / Encapsulado T-40E

SKU: 25C2097 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$758.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.5rem; font-weight: 600;'>Transistor NPN Epitaxial de Silicio para RF de Potencia</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 1rem;'>Este transistor NPN epitaxial de silicio está diseñado para aplicaciones de amplificación de radiofrecuencia de potencia con alta eficiencia energética. Opera a una frecuencia máxima de 30 MHz con estabilidad térmica y eléctrica garantizada por su estructura epitaxial de silicio. La tensión de colector de 13.5 Vcc permite integrarlo en etapas de salida de transmisores y amplificadores de RF que requieren manejo de señales de alta potencia. Su encapsulado T-40E proporciona disipación térmica eficiente para operación continua en entornos industriales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px; line-height: 1.8;'>Transistor NPN epitaxial de silicio para baja distorsión armónicaFrecuencia máxima de operación: 30 MHzTensión de colector: 13.5 VccPotencia máxima de salida: 70 WEncapsulado formato T-40E para montaje industrialOptimizado para amplificación RF de potencia<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Transistor</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>NPN Epitaxial de Silicio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>30 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tensión de Colector</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>13.5 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Potencia de Salida</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>70 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Encapsulado</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>T-40E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicación Principal</div><div style='font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Amplificación RF de Potencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia en amplificación RF de potencia
Característica 2	Operación estable hasta 30 MHz
Característica 3	Diseño epitaxial de silicio para baja distorsión
Característica 4	Encapsulado T-40E para disipación térmica optimizada
Característica 5	Tensión de colector 13.5 Vcc para circuitos robustos
Característica 6	Ideal para etapas de salida en transmisores